

**Российская конференция
и школа молодых ученых
по актуальным проблемам
полупроводниковой фотозлектроники
(с участием иностранных ученых)**

27-31 мая 2019 г.

ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСК
2019

Организаторы



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук
Веб-сайт: www.isp.nsc.ru



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
Веб-сайт: www.nsu.ru



Курорт-отель «Сосновка»
Веб-сайт: www.sosnovka.biz

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ:



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Веб-сайт: minobrnauki.gov.ru



Российский фонд фундаментальных исследований
Веб-сайт: www.rfbr.ru

Спонсоры



АО ОКБ "АСТРОН"
Веб-сайт: www.astrohn.ru



ООО «СибИС»
Веб-сайт: www.sib-is.ru



Группа компаний "Научное оборудование"
Веб-сайт: spegroup.ru

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель конференции

Латышев А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск

Зам. председателя

Двуреченский А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск

Милёхин А.Г. ИФП СО РАН, Новосибирск

Ученый секретарь

Аржанникова С.А. ИФП СО РАН, Новосибирск

Члены программного комитета

Алферов Ж.И. СПб АУ НОЦНТ РАН, Санкт-Петербург
Асеев А.Л. ИФП СО РАН, Новосибирск
Бабин С.А. ИАиЭ СО РАН, Новосибирск
Балоев В.А. АО «НПО «ГИПО», Казань
Борисов А.А. АО «Российская электроника», Москва
Волков Н.В. ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск
Гапоненко С.В. Институт физики НАН Беларуси, Минск
Гугучкин В.И. АО «Экран-оптические системы», Новосибирск
Гуляев Ю.В. ИРЭ РАН, Москва
Егоров А.Ю. ООО «Коннектор Оптик», Санкт-Петербург
Жуков А.Е. СПб АУ НОЦНТ РАН, Санкт-Петербург
Иванов С.В. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
Ивченко Е.Л. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
Исюк В.И. ОАО НЗПП с ОКБ, Новосибирск
Калюгин В.С. ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», Красногорск
Каргин Н.И. НИЯУ МИФИ, Москва
Красильник З.Ф. ИФМ РАН, Н. Новгород
Красников Г.Я. ПАО «НИИМЭ и Микрон», Зеленоград
Копьев П.С. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
Корчак В.Ю. Секция прикладных проблем при Президиуме РАН, Москва
Кукушкин И.В. ИФТТ РАН, Черногоровка
Кулипанов Г.Н. ИЯФ СО РАН, Новосибирск
Куцько П.П. МНИИРИП, Мытищи, Московская обл.
Лукичев В.Ф. ФТИАН, Москва
Неизвестный И.Г. ИФП СО РАН, Новосибирск

Никитов С.А. ИРЭ РАН, Москва
Овсяк В.Н. ИФП СО РАН, Новосибирск
Парамонова В.Ю. АО «НПФ «Микран», Томск
Резнев А.А. Москва
Сауров А.Н. ИНМЭ РАН, Москва
Сибельдин Н.Н. ФИАН, Москва
Сигов А.С. МИРЭА, Москва
Сидоров Ю.Г. ИФП СО РАН, Новосибирск
Сизов Ф.Ф. ИФП НАН Украины, Киев
Солдатенков В.А. ОАО «НПО Геофизика-НВ», Москва
Терехов А.С. ИФП СО РАН, Новосибирск
Устинов В.М. НТЦ микроэлектроники РАН, Санкт-Петербург
Федорук М.П. НГУ, Новосибирск
Хохлов Д.Р. МГУ, Москва
Хохлов С.В. Минпромторг, Москва
Чаплик А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск
Чепурнов Е.Л. АО «НПО «Орион», Москва
Шалагин А.М. ИАиЭ СО РАН, Новосибирск
Шулунов А.Н. АО «РТИ», Москв

Адреса и контакты Программного комитета

ФГБУН Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова
СО РАН

пр-т Академика Лаврентьева 13, 630090, Новосибирск,
Аржанникова София Андреевна – учёный секретарь

Программного комитета

Тел.: +7(383)333-24-88

E-mail: photonics2019@isp.nsc.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели

Каламейцев А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск
Милёхин А.Г. ИФП СО РАН, Новосибирск
Якушев М.В. ИФП СО РАН, Новосибирск

Зам. председателя

Девяткин П.Т. ИФП СО РАН, Новосибирск
Федоринин В.Н. Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ»,
Новосибирск

Ученый секретарь

Аржанникова С.А. ИФП СО РАН, Новосибирск

Члены оргкомитета

Бетеров И.И. ИФП СО РАН, Новосибирск
Бурлаков И.Д. АО «НПО «Орион», Москва
Войцеховский А.В. ТГУ, Томск
Гайслер В.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Грибков В.П. ИФП СО РАН, Новосибирск
Дворецкий С.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Журавлев К.С. ИФП СО РАН, Новосибирск
Карпов В.В. ОАО «Швабе - Фотосистемы», Москва
Локтионов В.И. ОАО «Катод», Новосибирск
Максимов Е.М. Москва
Паршин А.С. СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Красноярск
Паулиш А.Г. Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск
Потатуркин О.И. ИАиЭ СО РАН, Новосибирск
Рассохин В.А. АО «НПЗ», Новосибирск
Рябцев И.И. ИФП СО РАН, Новосибирск
Сидоров Г.Ю. ИФП СО РАН, Новосибирск
Чурилов С.М. Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

Адрес Оргкомитета Конференции

ФГБУН Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова
СО РАН

пр-т Академика Лаврентьева 13, 630090, Новосибирск,
Факс: +7(383) 333-27-71; e-mail: photonics2019@isp.nsc.ru

Аржанникова София Андреевна - ученый секретарь,
тел.: +7(383) 333-24-88;

Тычинская Светлана Анатольевна,
тел.: +7(383) 333-24-88

Мероприятие проводится при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований,
проект №19-02-20056.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

С 12⁰⁰ - заезд в пансионат «Сосновка»,

16⁰⁰-19⁰⁰ - регистрация участников Конференции

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

Конференц-зал пансионата «Сосновка»

РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ФОТОЭЛЕКТРОНИКИ

9⁰⁰-9³⁰ Регистрация участников конференции

9³⁰ - 9⁴⁵ Открытие конференции и школы. Вступительное слово.
А.В. Латышев

1-е заседание Председатель – Двуреченский А.В.

9⁴⁵ - 10¹⁵ *С.В.Иванов, В.Н.Жмерик*. Фотоника среднего УФ-диапазона на основе AlGaIn наногетероструктур. (*приглашенный доклад*). Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург.

10¹⁵ - 10⁴⁵ *В.П.Пономаренко, В.С.Попов, Е.Л.Чепурнов*. Новые материалы для фотоэлектронники на основе двумерных наноструктур (*приглашенный доклад*). НПО «Орион», Москва.

10⁴⁵ - 11⁰⁰ *В.П.Назьмов¹⁾, Б.Г.Гольденберг¹⁾, В.Е.Асадчиков²⁾, С.А.Бедин²⁾, А.Б.Васильев²⁾, А.В.Андреев³⁾, В.М.Гордиенко³⁾, А.А.Коновко³⁾, Ф.В.Потемкин³⁾*. Приповерхностные субмикроструктуры для эффективного детектирования и генерации гармоник излучения среднего ИК-диапазона.
¹Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск. ²Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника РАН», Москва. ³Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва.

11⁰⁰ - 11²⁰ Кофе-брейк

Председатель – Морозов С.В.

11²⁰ - 11⁵⁰ **М.В.Якушев**, В.С.Варавин, В.В.Васильев, С.А.Дворецкий, В.Г.Ремесник, И.В.Сабина, Г.Ю.Сидоров, Ю.Г.Сидоров, А.В.Латышев. Матричные ИК фотоприемники на основе гетероструктур узкозонных полупроводников (**приглашенный доклад**). *Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия.*

11⁵⁰ - 12²⁰ **К.Н.Стещенко**. Основные тенденции и перспективы развития оптико-электронных систем в авиационном приборостроении (**приглашенный доклад**). *АО «НПК Пеленгатор», Санкт-Петербург.*

12²⁰ - 12³⁵ **А.Г.Настовьяк**¹⁾, Н.Л.Шварц²⁾. Моделирование роста нанопроволок АПВВ методом импульсной эпитаксии. ¹*Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.* ²*Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.*

12³⁵ - 12⁵⁰ **Д.А.Пашкеев**¹⁾, **А.Д.Шабрин**¹⁾, В.С.Кривобок²⁾, И.Д.Бурлаков¹⁾. Спектры возбуждения фотолюминесценции многослойных структур с квантовыми ямами на основе гетеропары AlGaAs/GaAs для фотоприемных устройств. ¹*АО «НПО «Орион», Москва.* ²*ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва.*

12⁵⁰ - 13⁰⁵ **Е.А.Емельянов**, М.О.Петрушков, А.В.Васев, Б.Р.Семягин, М.А.Путято, И.Д.Лошкарев, В.В.Преображенский. Влияние скорости роста на состав слоев в подрешетке пятой группы при МЛЭ твердых растворов InAsSb. *Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.*

13⁰⁵ - 13²⁰ **А.Н.Папантопуло**^{1,2)}, Ф.В.Тихоненко²⁾. Создание фотослоя на основе селена с помощью импульсного отжига. ¹*Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.* ²*АО «НПП «Восток», Новосибирск.*

13²⁰ - 13³⁵ Выступление спонсоров

13³⁵ - 14³⁰ Обед

2-е заседание

Председатель – Милёхин А.Г.

14³⁰ - 15⁰⁰ **Р.Б.Васильев**. Коллоидные атомно-тонкие квантовые ямы на основе соединений A²B⁶ (**приглашенный доклад**). *Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва.*

15⁰⁰ - 15³⁰ **А.С.Баишкатов**, Д.Н.Мещерова. Основные тенденции развития оптоэлектронной техники до 2030 года (**приглашенный доклад**). *Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов, Мытищи, Московская область.*

15³⁰ - 15⁴⁵ **Д.В.Марин**¹⁾, И.А.Азаров^{1,2)}, В.А.Швец^{1,2)}, С.В.Рыхлицкий¹⁾, М.В.Якушев¹⁾, Е.В.Спесивцев¹⁾. Эллипсометрический метод бесконтактного in situ контроля температуры в процессах МЛЭ КРТ. ¹*Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.* ²*Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*

15⁴⁵ - 16⁰⁰ **О.А.Кошелев**, Д.В.Нечаев, В.В.Ратников, С.В.Иванов, В.Н.Жмерик. Управление генерацией и релаксацией упругих напряжений в AlN/c-Al₂O₃ темплейтах, выращенных методом плазменно-активированной МПЭ. *Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург.*

16⁰⁰ - 16¹⁵ **С.В.Мутилин**¹⁾, В.Я.Принц¹⁾, Л.В.Яковкина²⁾, В.А.Селезнев¹⁾, А.К.Гутаковский¹⁾. Упорядоченный массив вертикальных нанопроволок VO₂ на наноструктурированной поверхности Si. ¹*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.* ²*Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск.*

16¹⁵ - 16³⁰ **Е.В.Мостовщикова**¹⁾, В.И.Воронин¹⁾, Л.Н.Маскаева^{2,3)}, А.Д.Кутявина²⁾, Н.А.Чуфарова²⁾. Структурные и оптические свойства тонких пленок PbS:Fe. ¹*Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург.*

16³⁰ - 16⁵⁰ кофе-брейк

Председатель – Володин В.А.

16⁵⁰ - 17⁰⁵ **А.А.Шкляев**^{1,2)}, **А.В.Царёв**^{1,2)}, **Е.А. Колосовский**¹⁾, **К.В. Аникин**¹⁾, **А.Г. Милёхин**^{1,2)}. Покрытия из массивов субмикронных частиц Ge и их антиотражающие свойства. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова, СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

17⁰⁵ - 17²⁰ **Л.Н.Сафронов**, **В.А.Антонов**, **Э.Д.Жанаев**, **В.П.Попов**, **Е.В.Спесивцев**. Оптические свойства поверхности кремния после плазменных обработок. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.

17²⁰ - 17³⁵ Выступление спонсора

17³⁵ – 19⁰⁰ - стендовая сессия - 1

3-е заседание

Председатель – Иванов С.В.

9⁰⁰ - 9³⁰ **О.Е.Терещенко**^{1,2)}, **В.А.Голяшов**^{1,2)}, **В.С.Русецкий**^{1,3)}, **Н.С.Назаров**²⁾, **А.В.Миронов**³⁾, **В.В.Аксенов**³⁾. Оптическое детектирование спиновой поляризации свободных электронов в полупроводниковых гетероструктурах с пространственным разрешением (**приглашенный доклад**). ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³ЗАО «ЭКРАН-ФЭП», Новосибирск.

9³⁰ - 9⁴⁵ **А.В.Самвелов**, **С.Г.Ясев**, **А.С.Москаленко**, **К.С.Павлов**. Магнитоэлектрическая микрокриогенная система с комбинированным регенератором, работающая по обратному циклу Стирлинга для криостатирования фотоприёмных устройств. АО «Оптико-механическое конструкторское бюро «АСТРОН», Московская область, Лыткарино.

9⁴⁵ - 10⁰⁰ **А.Э.Климов**^{1,2)}, **А.Н.Акимов**¹⁾, **В.А.Голяшов**^{1,3)}, **Д.В.Иценко**¹⁾, **Н.С.Пащин**¹⁾, **С.П.Супрун**¹⁾, **А.С.Тарасов**¹⁾, **О.Е.Терещенко**^{1,3)}, **В.Н.Шерстякова**¹⁾, **В.С.Эпов**¹⁾. Локализованные состояния и фоточувствительность пленок PbSnTe:In в ИК и ТГц областях спектра. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск. ³Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

10⁰⁰ - 10¹⁵ **С.М.Пещерова**¹⁾, **Р.В.Пресняков**¹⁾, **А.И.Непомнящих**¹⁾, **Н.В.Клушина**^{1,2)}. Распределение примесей в мультикристаллическом кремнии, выращенном из UMG-кремния методом Бриджмена. ¹Институт геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН, Иркутск. ²Иркутский государственный университет, Иркутск.

10¹⁵-10³⁰ **В.В.Бакин**¹⁾, **С.Н.Косолобов**¹⁾, **С.А.Рожков**^{1,2)}, **Г.Э.Шайблер**^{1,2)}, **А.С.Терехов**¹⁾. Самопроизвольные перестройки атомной структуры полупроводниковых интерфейсов с Cs - покрытиями. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

10³⁰-10⁴⁵ **В.А.Голяшов**^{1,2)}, **Н.А.Назаров**²⁾, **В.С.Русецкий**^{2,3)}, **А.В.Миронов**²⁾, **В.В.Аксенов**²⁾, **О.Е.Терещенко**^{1,2)}. Эмиссия и инжекция электронов низких энергий в вакуумных диодах с электродами на основе полупроводниковых гетероструктур с эффективным отрицательным электронным сродством. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³ЗАО "ЭКРАН-ФЭП", Новосибирск.

10⁴⁵-11⁰⁰ Выступление спонсора

11⁰⁰-11³⁰ Кофе-брейк

Председатель – Терещенко О.Е.

11³⁰-12⁰⁰ **С.А.Бабин**, **А.В.Достовалов**, **А.Вольф**. Микро- и наноструктурирование оптических материалов с помощью фемтосекундного ИК излучения (**приглашенный доклад**). Институт автоматизации и метрологии СО РАН, Новосибирск.

12⁰⁰-12¹⁵ **А.Г.Милёхин**^{1,2)}, **М.Рахман**³⁾, **Т.А.Дуда**¹⁾, **И.А.Милёхин**¹⁾, **К.В.Аникин**¹⁾, **Е.Е.Родякина**^{1,2)}, **Р.Б.Васильев**⁴⁾, **В.М.Дзхган**⁴⁾, **D.R.T. Zahn**³⁾, **А.В.Латышев**^{1,2)}. Локальный спектральный анализ полупроводниковых нанокристаллов. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³Semiconductor Physics, Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Germany. ⁴Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва. ⁵V.Ye.Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Ukr. Nat. Acad. Sci., Kyiv, Ukraine.

12¹⁵-12³⁰ **А.В.Телегин**, **Ю.П.Сухоруков**, **В.Д.Бессонов**, **А.П.Носов**, **С.В.Наумов**. Стрейн-магнитооптика – новый физический механизм модуляции ИК-излучения в ферромагнитных шпинелях. Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН, Екатеринбург.

12³⁰-12⁴⁵ **С.М.Пещерова**¹⁾, **А.И.Непомнящих**¹⁾, **А.Г.Чуешова**^{1,2)}. Механизмы образования специальных границ наклона и кручения. ¹Институт геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН, Иркутск. ²Иркутский государственный университет, Иркутск.

12⁴⁵-13⁰⁰ **К.В.Аникин**¹⁾, **А.Г.Милёхин**^{1,2)}, **Е.Е.Родякина**^{1,2)}, **С.Л.Вебер**³⁾, **А.В.Латышев**^{1,2)}, **D.R.T.Zahn**⁴⁾. Оптические плазмонные резонансы в массивах нанокластеров Au. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³Международный томографический центр СО РАН, Новосибирск. ⁴Chemnitz University of Technology, Semiconductor Physics, Chemnitz, Germany.

13⁰⁰-13¹⁵ **ТБ.Залесский**, **А.И.Конойко**, **В.М.Кравченко**, **А.С.Мицкевич**. Электрооптическая амплитудная модуляция излучения на базе резонаторов Фабри-Перо. ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь.

13¹⁵-13³⁰ **В.В.Шелковников**, **Н.В.Васильева**, **Е.В.Васильев**, **И.Ю.Каргаполова**, **С.В.Коротаев**, **Н.А.Орлова**. Генерация второй гармоники в пленках донорно-акцепторный хромофор-полимер при повышении температуры в процессе полинга. Новосибирский институт органической химии им. Н.Н.Ворожцова СО РАН, Новосибирск.

13³⁰-14³⁰ Обед

- 14³⁰-15⁰⁰ **А.П.Шкуринов**. Нелинейная ТГц фотоника жидкостей (*приглашенный доклад*). Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва.
- 15⁰⁰-15³⁰ **С.В.Морозов¹⁾**, В.В.Румянцев¹⁾, В.В.Уточкин¹⁾, Н.С.Куликов¹⁾, М.С.Жолудев¹⁾, М.А.Фадеев¹⁾, В.Я.Алёшкин¹⁾, Н.Н.Михайлов²⁾, В.И.Гавриленко¹⁾. Конкуренция излучательной и оже-рекомбинации в узкозонных волноводных структурах с квантовыми ямами HgTe/CdHgTe излучающих в среднем и дальнем ИК диапазонах (*приглашенный доклад*). ¹Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород. ²Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 15³⁰-15⁴⁵ **Р.И.Баталов**, Р.М.Баязитов. Гипердопированный кремний для фотоэлектроники. Казанский физико-технический институт, Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН», Казань.
- 15⁴⁵-16⁰⁰ **Д.В.Горшков**, В.С.Варавин, Г.Ю.Сидоров, В.Г.Ремесник, И.В.Сабинаина. Обратная конверсия типа проводимости ГЭС КРТ МЛЭ после плазмохимического травления при пониженной температуре. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 16⁰⁰-16¹⁵ **В.А.Холоднов^{1,2,3,4)}**, И.Д.Бурлаков^{1,2)}, А.К.Ильясов¹⁾. Коэффициенты умножения фотоносителей в лавинных гетерофотоидах с разделенными областями поглощения и умножения. ¹АО «НПО «Орион», Москва. ²МИРЭА – Российский технологический университет, Москва. ³Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, Москва. ⁴МФТИ, Москва.
- 16¹⁵-16³⁰ **В.Г.Ремесник¹⁾**, Н.Н.Михайлов^{1,2)}, С.А.Дворецкий^{1,3)}, И.Н.Ужаков¹⁾. Экспериментальное определение уровней размерного квантования в структурах на основе квантовых ям твердых растворов Cd_xHg_{1-x}Te. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,

Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск.

- 16³⁰-16⁴⁵ **В.Ф.Марков^{1,2)}**, Л.Н.Маскаева^{1,2)}, А.Д.Кутявина¹⁾, И.В.Ваганова²⁾, И.Н.Мирошникова³⁾, Б.Н.Мирошников³⁾. Спектральные и фотоэлектрические характеристики гидрохимически осажденных пленок твердых растворов замещения Cd_xPb_{1-x}S. ¹Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, Екатеринбург. ²Уральский институт ГПС МЧС России, Екатеринбург. ³Московский энергетический институт, Москва.

16⁴⁵-17⁰⁰ Кофе-брейк

Председатель – Шкуринов А.П.

- 17⁰⁰-17¹⁵ Ю.Г.Сидоров, И.В.Сабинаина, **Г.Ю.Сидоров**, Д.В.Марин, В.В.Васильев, М.В.Якушев, Ю.С.Макаров, А.В.Зверев, И.В.Марчишин, А.В.Предеин, В.С.Варавин, С.А.Дворецкий, А.В.Вишняков, В.Г.Ремесник, Д.В.Горшков, А.В.Латышев. Фотоприемные модули на основе ГЭС КРТ МЛЭ для спектральных диапазонов 1-3, 3-5, 8-10 мкм форматом до 2000×2000 элементов. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 17¹⁵-17³⁰ **Н.А.Паханов**. Разработка высокоэффективных, сверхлегких солнечных панелей на основе ультратонких солнечных элементов на гетероструктурах A^{III}B^V/Ge. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова, Новосибирск.
- 17³⁰-17⁴⁵ **М.А.Демьяненко**. Микроболометрические приемники импульсного терагерцового и субмиллиметрового излучения. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 17⁴⁵-18⁰⁰ **А.В.Полесский**. Структура методик измерения параметров ФПУ второго поколения. АО «НПО «Орион», Москва.
- 18⁰⁰-18¹⁵ **Е.В.Сусов**, А.В.Гусаров, А.В.Филатов, В.В.Карпов, П.Д.Гиндин. Фоторезисторы из Cd_xHg_{1-x}Te с радиальным

смещением и эффектом эксклюзии носителей заряда. АО «Московский завод «Сапфир», Москва.

- 18¹⁵-18³⁰ **А.Г.Коротаев¹⁾**, И.И.Ижнин^{1,2)}, Е.И.Фицыч²⁾, А.В.Войцеховский¹⁾, К.Д.Мынбаев^{3,4)}, В.С.Варавин⁵⁾, С.А.Дворецкий^{1,5)}, Н.Н.Михайлов⁵⁾, В.Г.Ремесник⁵⁾, М.В.Якушев⁵⁾, О.Ю.Бончик⁶⁾, Г.В.Савицкий⁶⁾, Y.Morgiel⁷⁾, Z.Świątek⁷⁾. Радиационные донорные дефекты в имплантированных As пленках МЛЭ CdHgTe: пространственное распределение и природа. ¹Национальный исследовательский Томский госуниверситет, Томск. ²Научно-производственное предприятие «Электрон-Карат», Львов, Украина. ³Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург. ⁴Университет ИТМО, Санкт-Петербург. ⁵Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ⁶ИППММ им. Я.С. Пидстригача НАН Украины, Львов, Украина. ⁷Institute of Metallurgy and Material Science PAN, Krakow, Poland.
- 18³⁰-18⁴⁵ **И.И.Ли¹⁾**, В.Г.Половинкин^{1,2)}. Фотоэлектрические характеристики фотодиодных ИК ФПУ с учетом пространственного распределения локальной квантовой эффективности. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.

5-е заседание

Председатель – Новиков А.В.

- 9⁰⁰-9³⁰ В.Д.Шаргородский¹⁾, **А.Б.Александров¹⁾**, А.А.Бабаев²⁾. Требования, предъявляемые к современным матричным фотоприёмникам наземных оптико-электронных систем (**приглашенный доклад**). ¹АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», Москва. ²Филиал АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», Великий Новгород.
- 9³⁰-10⁰⁰ **А.И.Якимов**. Поверхностные плазмонные волны в гибридных фотодетекторах Ge/Si с металлическими субволновыми решетками (**приглашенный доклад**). Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 10⁰⁰-10¹⁵ **К.О.Болтарь^{1,2)}**, И.Д.Бурлаков^{1,3)}, С.В.Головин¹⁾, А.В.Никонов^{1,2)}, Н.И.Яковлева¹⁾. Инфракрасная радиометрия на основе многогорядных инфракрасных фотоприемных устройств. ¹АО «НПО «Орион», Москва. ²МФТИ, Москва. ³МИРЭА – Российский технологический университет, Москва.
- 10¹⁵-10³⁰ М.В.Якушев, В.С.Варавин, И.В.Сабина, Г.Ю.Сидоров, Д.В.Марин, А.В.Предеин, С.А.Дворецкий, **В.В.Васильев**, Ю.Г.Сидоров, А.В.Латышев. Формирование фотодиодов на основе р-п переходов в слоях ГЭС КРТ МЛЭ для спектрального диапазона 8-11 мкм. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 10³⁰-10⁴⁵ **К.В.Козлов^{1,2)}**, В.А.Стрельцов^{1,2)}, Б.Н.Дражников¹⁾, Я.С.Бычковский¹⁾. Методы повышения чувствительности многогорядных фотоприемных устройств для регистрации малоразмерных объектов. ¹АО «НПО «Орион», Москва. ²МФТИ, Москва.

10⁴⁵-11⁰⁰ *А.Н.Акимов¹⁾, И.О.Ахундов^{1,2)}, **Д.В.Ищенко¹⁾**, А.Э.Климов^{1,3)}, Н.С.Пащин¹⁾, С.П.Супрун¹⁾, А.С.Тарасов¹⁾, О.Е.Терещенко^{1,3)}, Е.В.Федосенко¹⁾, В.Н.Шерстякова¹⁾. Влияние поверхности на фотопроводимость плёнок Pb_{1-x}Sn_xTe:In с составом 0,28 ≤ x ≤ 0,32. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.*

11⁰⁰ - 11²⁰ Кофе-брейк

Председатель – Егоров А.Ю.

11²⁰ - 11⁵⁰ ***С.Г.Кочура**, С.И.Опенько, М.В.Нестеришин, П.А.Крючков, Е.О.Воронцова.* Текущее состояние и актуальные направления развития космической фотоэнергетики (**приглашенный доклад**). АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», г.Железнодорожск Красноярского края

11⁵⁰ - 12²⁰ ***А.Е. Жуков¹⁾**, Н.В. Крыжановская¹⁾, Э.И. Моисеев¹⁾, А.М. Можаров¹⁾, Ф.И. Зубов¹⁾, Н.А. Калюжный²⁾, С.А. Минтаиров²⁾, М.М. Кулагина²⁾, С.А. Блохин²⁾, М.В. Максимов^{1,2)}. Быстродействующие температурно-стабильные микролазеры (**приглашенный доклад**). ¹Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН, Санкт-Петербург. ²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург.*

12²⁰ - 12³⁵ ***О.И.Семенова.*** Металлорганические перовскиты для фотоники. *Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск*

12³⁵ - 12⁵⁰ ***М.Д.Шарков**, М.Е.Бойко, А.В.Бобыль, А.М.Бойко, С.Г.Конников.* Рентгеновские исследования образцов микрокристаллического кремния для панелей солнечных элементов. ¹Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург.

12⁵⁰ - 13⁰⁵ *И.М.Жильцов¹⁾, **Н.В.Латухина¹⁾**, Д.А.Лизункова¹⁾, Г.А.Рогожина¹⁾, М.В.Степихова²⁾. Перспективы пористого кремния как материала для оптоэлектронных приложений. ¹Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П. Королева, Самара. ²Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород.*

13⁰⁵ - 13²⁰ ***А.В.Новиков¹⁾**, Д.В.Юрасов¹⁾, А.Н.Яблонский¹⁾, Н.А.Байдакова¹⁾, Е.Е.Морозова¹⁾, В.А.Вербус^{1,2)}, Н.С.Гусев¹⁾, Д.В.Шенгуров¹⁾, А.В.Нежданов³⁾, А.И.Машин³⁾. Светоизлучающие структуры для кремниевой оптоэлектроники на основе локально растянутых Ge микроструктур. ¹Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород. ²НИУ Высшая Школа Экономики, Нижний Новгород. ³Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород.*

13²⁰ - 13³⁵ Выступление спонсора

13³⁵ - 14³⁰ Обед

14³⁰ - 15⁰⁰ ***И.А.Деребезов^{1,2)}**, В.А.Гайслер¹⁾, А.В.Гайслер¹⁾, Д.В.Дмитриев¹⁾, А.И.Торопов¹⁾, М. von Helversen³⁾, С. de la Haye³⁾, S.Boinoniar³⁾, S.Reitzenstein³⁾. Неклассические излучатели света на основе селективно-позиционированных гибридных микрорезонаторов и (111)In(Ga)As квантовых точек (**приглашенный доклад**). ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирск. ³Technische Universität Berlin, Institut für Festkörperphysik Eugene-Wigner-Gebäude, Berlin.*

15⁰⁰ – 19⁰⁰ - Экскурсии

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

6-е заседание

Председатель – Устинов В.М.

- 9⁰⁰-9³⁰ **А.Ю.Егоров**. Быстродействующие вертикально-излучающие лазеры диапазона 1550 нм (**приглашенный доклад**). ООО «Коннектор Оптикс», Санкт-Петербург.
- 9³⁰-10⁰⁰ **В.И.Гавриленко**. Излучатели терагерцового диапазона на основе полупроводниковых наноструктур (**приглашенный доклад**). Институт физики микроструктур РАН – филиал Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород.
- 10⁰⁰-10¹⁵ **Ж.В.Смагина¹⁾**, В.А.Зиновьев¹⁾, В.А.Армбристер¹⁾, Е.Е.Родякина^{1,2)}, Б.И.Фомин¹⁾, М.В.Степихова³⁾, А.Н.Яблонский³⁾, А.В.Новиков³⁾, А.В.Двуреченский^{1,2)}. Ge/Si структуры с упорядоченными квантовыми точками, встроенными в микрорезонаторы. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород
- 10¹⁵-10³⁰ **В.А.Володин^{1),2)}**, В.А.Тимофеев¹⁾, М.П.Синюков¹⁾, А.И.Никифоров¹⁾. Фотолюминесценция SiSnGe гетероструктур. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 10³⁰-10⁴⁵ М.В.Степихова¹⁾, А.Н.Яблонский¹⁾, С.А.Дьяков²⁾, Е.В.Скороходов¹⁾, С.М.Сергеев¹⁾, М.В.Шалеев¹⁾, Д.В.Шенгуров¹⁾, **А.В.Новиков^{1,3)}**, З.Ф.Красильник^{1,3)}. Явления усиления сигнала фотолюминесценции nanoостровков Ge(Si) в фотонных кристаллах. ¹Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород. ²Сколковский институт науки и технологий, Москва. ³Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород.
- 10⁴⁵-11⁰⁰ **Н.А.Николаев¹⁾**, А.А.Мамрашев¹⁾, Ю.М.Андреев²⁾, Г.В.Ланский²⁾. Генерация терагерцового излучения в нелинейно оп-

тических кристаллах ВВО, ЛВО и КТР под действием интенсивного лазерного излучения. ¹Институт автоматизации и электрометрии СО РАН, Новосибирск. ²Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск.

11⁰⁰-11³⁰ Кофе-брейк

Председатель – Жуков А.Е.

- 11³⁰-12⁰⁰ **В.М. Устинов^{1,2)}**, Н.А. Малеев²⁾, С.А. Блохин²⁾ Полупроводниковые вертикально-излучающие лазеры для компактных атомных сенсоров (**приглашенный доклад**). ¹НТЦ Микроэлектроники РАН, Санкт-Петербург. ²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург.
- 12⁰⁰-12³⁰ А.В.Галева¹⁾, А.С.Казаков¹⁾, А.И.Артакин¹⁾, Л.И.Рябова²⁾, С.А.Дворецкий³⁾, Н.Н.Михайлов³⁾, М.И.Банников⁴⁾, С.Н.Данилов⁵⁾, С.Д.Ганичев⁵⁾, **Д.Р.Хохлов^{1,4)}**. РТ-симметрия терагерцовой фотопроводимости в структурах на основе Hg_{1-x}Cd_xTe с инверсным спектром (**приглашенный доклад**). ¹Физический факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва. ²Химический факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва. ³Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ⁴Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва. ⁵University of Regensburg, Regensburg, Germany.
- 12³⁰-12⁴⁵ **Н.Н.Рубцова¹⁾**, Г.М.Борисов^{1,2)}, В.Г.Гольдорт¹⁾, А.А.Ковалёв¹⁾, Д.В.Ледовских¹⁾, В.В.Преображенский¹⁾, М.А.Путьято¹⁾, Б.Р.Семягин¹⁾. Широкополосные быстродействующие полупроводниковые зеркала для пассивной синхронизации мод лазеров ближнего ИК диапазона. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 12⁴⁵-13⁰⁰ **Д.С.Абрамкин^{1),2)}**, М.О.Петрушков¹⁾, М.А.Путьято¹⁾, Б.Р.Семягин¹⁾, Е.А.Емельянов¹⁾, Д.Б.Богомолов¹⁾, Т.С.Шамирзаев^{1),2)}. Светоизлучающие InAs/GaP гетероструктуры, выращенные на Si подложках. ¹Институт физики полуп-

роводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

13⁰⁰-13¹⁵ **Е.А.Вилков¹⁾**, М.В.Логунов²⁾, С.А.Никитов^{2,3)}, С.С.Сафонов²⁾, С.Г.Чигарев¹⁾. Неравновесные спиновые состояния и генерация терагерцового излучения в магнитных гетероструктурах. ¹Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, Фрязино. ²Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Москва, ³Московский физико-технический институт (ГУ), Долгопрудный.

13¹⁵-13³⁰ Выступление спонсора

13³⁰-14³⁰ Обед

7-е заседание **Председатель – Потатуркин О.И.**

14³⁰-15⁰⁰ **К.С.Журавлев¹⁾**, Д.В.Дмитриев¹⁾, А.И.Торопов¹⁾, М.С.Аксенов¹⁾, Н.А.Валишева¹⁾, А.М.Гилинский¹⁾, И.Б.Чистохин¹⁾, А.Л.Чиж²⁾, С.А.Мальшиев²⁾, К.Б.Микитчук²⁾. Приборы радиофотоники на основе фосфида индия (**приглашенный доклад**). ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь.

15⁰⁰-15³⁰ С.Д.Сапрыкин, **А.Н.Шудунов**, В.В.Валуев, А.Гаврюшин, И.Н.Крикунов, Д.Фофанов, С.Головин. Опыт проектирования и создания радиофотонного Радиолокатора X диапазона с фотонным гетеродином и другими элементами радиофотоники. Опыт создания и результаты испытаний радиофотонных АЦП - X диапазона. Общее состояние и перспективы развития радиофотоники в России. (**приглашенный доклад**). АО «НПК «НИИДАР», Москва.

15³⁰-15⁴⁵ **С.А.Кузнецов^{1,2,3)}**, А.В.Гельфанд¹⁾, В.Н.Федоринин¹⁾, А.В.Аржанников^{2,3)}, Н.А.Николаев⁴⁾. Функциональные оптические элементы и устройства терагерцовой фотоники на основе метаповерхностей. ¹Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско - технологический ин-

ститут прикладной миктоэлектроники», Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск. ⁴Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.

15⁴⁵–16⁰⁰ **О.В.Наумова**, Б.И.Фомин, Д.В.Щеглов. Перспективные конструкции электро-оптических модуляторов на кремнии. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.

16⁰⁰-16¹⁵ **А.В.Царев^{1,2)}**, Р.М.Тазиев¹⁾. Свойства электрооптического модулятора на основе квантово-размерного эффекта Штарка в двуслойном гребенчатом волноводе InAlGaAs на подложке InP. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

16¹⁵-16³⁰ Кофе-брейк

Председатель – Журавлев К.С.

16³⁰-17⁰⁰ **В.К.Струк**. Прикладные вопросы проектирования и изготовления фотонных компонентов для приборов и систем (**приглашенный доклад**). НИИ радиофотоники и оптоэлектроники ПАО ПНППК, Пермь.

17⁰⁰-17³⁰ **Р.З.Ибрагимов**, И.А.Конаев. Первый российский 40 Гбит/с BPSK- модулятор на основе волоконного интерферометра Маха-Цендера и его применение для решения задач передачи и обработки аналогового сигнала (**приглашенный доклад**). ООО «Т8», Москва.

17³⁰-17⁴⁵ **Л.Д.Козина**, А.В.Гаршев, Р.Б.Васильев. Коллоидные квантовые ямы теллурида кадмия: синтез и влияние обмена лигандов на оптические свойства. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва.

17⁴⁵-18⁰⁰ **М.В.Агринский**, В.М.Волынкин, В.В.Старцев. Создание и применение нетрадиционных оптических материалов с повышенной радиационной устойчивостью. АО «Оптико-механическое конструкторское бюро «АСТРОН», Московская область, г. Лыткарино.

18⁰⁰-19⁰⁰ **стендовая сессия - 2**

- 9⁰⁰-9³⁰ **О.И.Потатуркин**, С.М.Борзов. Комплексная мульти- и гиперспектральная обработка изображений видимого и ИК диапазонов в задачах обнаружения и классификации объектов на неоднородном фоне (**приглашенный доклад**). *Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.*
- 9³⁰-10⁰⁰ А.В.Голицын, И.И.Кремис, А.О.Лебедев, Б.Н.Новгородов, А.Г.Паулиш, **В.Н.Федоринин**, П.И.Шапор, К.П.Шатунов. Цифровые методы повышения качества изображения в тепловизионных приборах (**приглашенный доклад**). *Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск.*
- 10⁰⁰-10¹⁵ **Р.А.Гладков**, И.И.Кремис. Микросканер на базе синхронного двигателя с внешним ротором для тепловизоров третьего поколения. *Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск.*
- 10¹⁵-10³⁰ В.М.Базовкин¹⁾, С.А.Дворецкий¹⁾, А.В.Зверев¹⁾, А.П.Ковчавцев¹⁾, **Ю.С.Макаров**^{1,2)}, Г.Ю. Сидоров¹⁾, А.В.Глухов²⁾, И.А.Смирнов²⁾, Д.В.Фромичев²⁾. Интегральные микросхемы считывания для ИК фотоприемников на основе твердых растворов теллуридов кадмия-ртути. ¹*Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.* ²*АО «НПП «Восток», Новосибирск.*
- 10³⁰-10⁴⁵ **Б.Г.Вайнер**^{1,2)}, А.Е.Настовьяк¹⁾, А.В.Шепелин²⁾, Э.А.Эминов²⁾. Тепловизионная автоматизированная система для экспериментальных исследований сорбционных и каталитических свойств поверхности твердых тел. ¹*Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.* ² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*

- 11⁰⁵-11²⁰ **Н.Н.Михайлов**^{1,2)}, С.А.Дворецкий^{1,3)}, Д.Г.Икусов¹⁾, В.В.Карпов⁴⁾, В.Г.Ремесник¹⁾, В.А.Швец^{1,2)}, Е.В.Сусов⁴⁾, И.Н.Ужасков¹⁾, А.В.Филатов⁴⁾, В.А.Швец^{1,2)}. Структуры с квантовыми ямами HgTe/CdHgTe для ИК фотоприемников: рост и характеристикация. ¹*Институт физики полупроводников им.А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.* ²*Новосибирский государственный университет, Новосибирск.* ³*Томский государственный университет, Томск.* ⁴*АО «Московский завод «Сапфир», Москва.*
- 11²⁰-11³⁵ **А.В.Телегин**, Б.А.Гижевский, Е.В.Мостовщикова, Ю.П.Сухоруков. Наноструктурированные магнитные полупроводники для ИК-оптоэлектроники. *Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург.*
- 11³⁵-11⁵⁰ В.Б.Залесский, **А.И.Конойко**, В.М.Кравченко, К.А.Решиков. Стабилизация характеристик термооптического преобразователя на базе матрицы микрорезонаторов Фабри-Перо. *ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь.*
- 11⁵⁰-12⁰⁵ **В.Г.Волков**, П.Д.Гиндин, В.В.Карпов. Псевдобинокулярные очки ночного видения с зеркально-линзовым и линзовым объективами. *Акционерное общество «Московский завод «САПФИР», Москва.*
- 12⁰⁵ – Закрытие конференции**

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

Стендовая сессия-1

- П_1** К.Е.Аношин, А.В.Наумов, В.В.Старцев. К вопросу создания эффективных тепловых узлов установок выращивания монокристаллов германия. *АО «АСТРОН», Московская область, г. Лыткарино.*
- П_2** Д.С.Басалаева¹⁾, Ю.В.Настаушев¹⁾, Ф.Н.Дульцев¹⁾ Н.В.Крыжановская²⁾, М.В.Фетисова²⁾, С.А.Щербак²⁾. Характеристики отражения света от микромассивов кремниевых нанопилларов, сформированных на подложках КНИ. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, ²СПбАУ, Санкт-Петербург.
- П_3** В.Е.Гончаров^{1,2)}, А.В.Никонов^{1,3)}, А.К.Ильясов¹⁾. Контроль распределения концентрации носителей заряда в гетероструктурах AlGaAs/GaAs. ¹АО «НПО «Орион», Москва. ²МИРЭА – Российский технологический университет, Москва. ³МФТИ, Москва.
- П_4** Д.В.Дмитриев, А.И.Торопов, А.М.Гишинский, Д.А.Колосовский, Т.А.Гаврилова, А.С.Кожухов, К.С.Журавлёв. Влияние условий отжига подложки (001)InP в потоке As на качество эпитаксиальных слоёв InAlAs. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.*
- П_5** С.А.Дулин, С.В.Рыхлицкий, Е.К.Иванов, Н.И.Назаров, Н.Н.Михайлов, С.А.Дворецкий, М.В.Якушев. In-situ контроль температуры поверхности ГЭС КРТ в процессе роста методом низкотемпературной поляризационной пирометрии. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.*
- П_6** Д.В.Ильинов¹⁾, А.Д.Шабрин¹⁾, Д.А.Пашикеев¹⁾. Анализ рентгеновских спектров дифракционного отражения для контроля параметров фотоприемных структур с множественными квантовыми ямами. ¹АО «НПО «Орион», Москва.

- П_7** А.В.Царев^{1,2)}, Р.М.Тазиев¹⁾. Моделирование кремниевого электрооптического модулятора с адиабатическим рупором для решеточного элемента связи с оптическим волокном. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- П_8** Д.А.Колосовский^{1,2)}, Д.В.Дмитриев¹⁾, А.И.Торопов¹⁾, А.М.Гишинский¹⁾, Т.А.Гаврилова¹⁾, А.С.Кожухов¹⁾, К.С.Журавлёв¹⁾. Синтез InAlAs/InP гетероструктур для приборов радиофотоники. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- П_9** А.П.Коханенко, К.А.Лозовой, Р.М.Х.Духан, В.В.Дирко, А.В.Войцеховский. Оптимизация режимов эпитаксиального синтеза структур с квантовыми точками для фотоприемников и солнечных элементов. *Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск.*
- П_10** В.Н.Кручинин¹⁾, М.С.Лебедев²⁾, Е.В.Спесивцев¹⁾, С.В.Рыхлицкий¹⁾. Оптические свойства тонких слоев $\text{Hf}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_2$ ($1 \leq x \leq 1$), полученных методом молекулярного наслаивания. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск.
- П_11** Д.А.Куртина¹⁾, А.В.Гаршев²⁾, Р.Б.Васильев³⁾. Рост ультратонкой популяции коллоидных наночастиц CdSe с УФ люминесценцией ¹Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва.
- П_12** В.А.Швец^{1,2)}, С.А.Дворецкий^{1,3)}, Н.Н.Михайлов^{1,2)}, Д.Г.Икусов¹⁾, И.Н.Ужаков¹⁾. Эллипсометрический метод in situ расчёта профиля состава квантовых структур, выращиваемых на основе соединения $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск.

- П_13** **И.Н.Мирошникова**^{1,2)}, **Б.Н. Мирошников**^{1,2)}, **М. Ю. Пресняков**³⁾, **В.П. Астахов**⁴⁾. Влияние морфологии супраструктуры поликристаллических пленок халькогенидов свинца на спектральную плотность мощности шума. ¹Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва. ²Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН, Москва. ³Национальный исследовательский центр Курчатовский институт, Москва. ⁴АО «Московский завод «Сапфир», Москва.
- П_14** **К.Д.Мынбаев**^{1,2)}, **Н.Л.Баженов**²⁾, **Д.А.Андрющенко**¹⁾, **В.С.Варавин**³⁾, **Н.Н.Михайлов**³⁾, **Д.В. Марин**³⁾, **С.А.Дворецкий**³⁾, **В.Г.Ремесник**³⁾, **М.В.Якушев**³⁾. Разупорядочение кристаллической решетки и точечные дефекты в слоях HgCdTe, выращенных методом МЛЭ на подложках Si и GaAs. ¹Университет ИТМО, Санкт-Петербург. ²Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург. ³Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, Новосибирск.
- П_15** **М.О.Петрушков**, **М.А.Пулято**, **Б.Р.Семягин**, **Е.А.Емельянов**, **Д.С.Абрамкин**, **А.В.Васев**, **Д.Б.Богомолов**, **В.В.Преображенский**. МЛЭ буферных слоев GaP на Si для формирования квантово-размерных гетероструктур. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.*
- П_16** **Е.Ю.Подшибякина**, **Т.В.Кулаковская**, **А.Ф.Шиманский**. Контейнеры для выращивания кристаллов германия. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Институт цветных металлов и материаловедения, Красноярск.
- П_17** **В.В. Танеев**, **А.В.Щербак**. Гетероструктура карбид кремния на кремнии для солнечных элементов. Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Самара.

- П_18** **В.А.Тимофеев**¹⁾, **В.И.Машанов**¹⁾, **А.И. Никифоров**^{1,2)}, **Т.А.Гаврилова**¹⁾, **Д.В.Гуляев**¹⁾, **И.А.Четырин**³⁾, **С.А.Тийс**¹⁾, **А.К.Гутаковский**¹⁾. Использование Sn в качестве катализатора роста бездислокационных наноструктур SiSn. ¹Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Томский государственный университет, Томск. ³Институт катализа имени Г.К.Борескова СО РАН, Новосибирск.
- П_19** **П.В.Гейдт**¹⁾, **П.А.Алексеев**²⁾, **В.А.Шаров**²⁾, **И.П.Сошников**²⁾, **В.В.Лысак**²⁾, **Г.Э.Цырлин**²⁾, **Е.Lähderanta**³⁾. Пьезо-фототронный эффект в вюрцитной фазе нановискеров из GaAs. ¹Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ²Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург. ³LUT-University, Lappeenranta, Finland.
- П_20** **В.В.Карпов**, **М.Е.Козырев**, **Н.С.Кузнецов**, **А.В.Маруценко**, **В.И.Петренко**, **Е.В.Сусов**, **А.В.Филатов**. Стенд для исследования параметров фотоприемника ФУР 160 при воздействии лазерного излучения. АО «Московский завод «Сапфир», Москва.
- П_21** **М.Ф.Ступак**^{1,2)}, **Н.Н. Михайлов**^{2,3)}, **С.А. Дворецкий**^{3,4)}, **М.В. Якушев**³⁾. Экспрессная характеристика кристаллического совершенства структур Cd_xHg_{1-x}Te методом генерации на отражение второй гармоники зондирующего излучения. ¹КТИ НП СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ⁴НИ ТГУ, Томск.
- П_22** **Д.Е.Ипатов**¹⁾, **А.В.Зверев**²⁾. Разработка нейроморфного акселератора. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова, Новосибирск. ²ООО «Мотив НТ», Москва.
- П_23** **А.В.Новиков**¹⁾, **М.В.Шалеев**¹⁾, **Д.В.Юрасов**¹⁾, **Н.А.Байдакова**¹⁾, **Е.Е.Морозова**¹⁾, **У.Ота**²⁾, **V.H.Nguyen**²⁾, **К.Gotoh**²⁾, **У.Kurokawa**²⁾, **N.Usami**²⁾. Применение Ge(Si) самоформирующихся nanoостровков для создания эффективных солнечных

элементов на основе тонкого кристаллического кремния.
¹Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород. ²Nagoya University, Nagoya, Japan.

- П_24** И.Б.Чистохин¹⁾, Б.И.Фомин¹⁾, В.В.Преображенский¹⁾, В.Г.Сидоров²⁾, П.В.Зеленков²⁾, А.Т.Лелеков^{2),3)}. Кремниевый бетавольтаический преобразователь. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск. ³Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН», Красноярск.
- П_25** И.В.Осинных, Т.В.Малин, Д.С. Милахин, И.А. Александров, К.С. Журавлев. Рост гетероструктур AlGaIn:Si брегговских зеркал для спектрального диапазона, соответствующего зеленой люминесценции. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- П_26** М.С.Аксенов¹⁾, А.А.Нужина^{1),2)}, Н.А.Валишева¹⁾, Д.В.Дмитриев¹⁾, А.К.Гутаковский¹⁾, А.П.Ковчавцев¹⁾. Пассивация поверхности InAlAs анодными слоями, сформированными в таунсендовской газоразрядной плазме. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.
- П_27** М.С.Аксенов, И.Б.Чистохин, Н.А.Валишева, Д.В.Дмитриев, К.С.Журавлев. Влияние плотности ростовых ямочных дефектов поверхности InAlAs на температурные зависимости параметров Au/Ti/n-InAlAs(001) диодов Шоттки. Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- П_28** Д.В.Гуляев¹⁾, Д.В.Дмитриев¹⁾, А.И.Торопов¹⁾, Н.А.Валишева¹⁾, А.В.Царев^{1),2)}, Е.А.Колосовский¹⁾, Л.А.Федюхин¹⁾, А.В.Горчаков²⁾, К.С.Журавлев²⁾. Гетероэпитаксиальные структуры InAlGaAs на подложке InP для электрооптического модулятора на основе квантово-размерного

эффекта Штарка. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

- П_29** Е.А.Колосовский¹⁾, Л.А.Федюхин¹⁾, К.С. Журавлёв¹⁾, Д.В. Гуляев¹⁾, А.В.Горчаков²⁾, Д.В.Дмитриев¹⁾. Методика ИК-интерферометрических измерений оптических параметров и толщин разнородных слоёв InGaAs - InAlAs в гетероструктурах на подложках из фосфида индия. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- П_30** Е.А.Колосовский¹⁾, Л.А. Федюхин¹⁾, К.С. Журавлёв¹⁾, Д.В. Гуляев¹⁾, А.В. Горчаков²⁾, Д.В. Дмитриев¹⁾. Измерение электрооптического эффекта в сверхрешетках InAlAs/InGaAlAs ИК-интерферометрической методикой. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- П_31** К.А.Свит, А.А.Зарубанов, К.С.Журавлев. Температурная зависимость времени жизни в нанокристаллах CdS, сформированных с помощью метода Ленгмюра-Блоджетт. Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- П_32** В.Г.Средин¹⁾, А.В.Войцеховский²⁾. Модель дефектообразования в Cd_xHg_{1-x}Te под действием мягкого рентгеновского излучения. ¹Военная академия РВСН им.Петра Великого, МО, г. Балашиха. ²Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск.
- П_33** В.С.Хорошилов^{1),2)}, А.Г.Журавлев^{1),2)}, Д.М.Казанцев^{1),2)}, В.Л.Альперович^{1),2)}. Релаксационная кинетика фотоэмиссии из GaAs со слоями цезия. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

- П_34** Г.Э.Шайблер^{1,2)}, В.В.Бакин¹⁾, С.Н.Косолюбов¹⁾, С.А.Рожков^{1,2)}, А.С.Терехов¹⁾. Новые электронные состояния на интерфейсе р-GaN(Cs,O)-вакуум при больших (Cs,O)-покрытиях. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск
- П_35** И.А.Шишкин, Д.А.Лизункова. Фотоэлектрические и оптические свойства многослойных структур с использованием рог-Si, изготовленным по различным технологическим маршрутам. ¹Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, г. Самара.
- П_36** З.Д.Квон^{1,2)}, О.А.Ткаченко¹⁾, В.А.Ткаченко^{1,2)}, Д.Г.Бакиев²⁾, А.С.Ярошевич¹⁾, Е.Е.Родякина^{1,2)}, А.В.Латышев^{1,2)}, М.Оттенедер³⁾, S.D.Ganichev³⁾. Туннельный точечный контакт в терагерцовом поле. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³Terahertz Center, University of Regensburg, Regensburg, Germany.
- П_37** О.А.Ткаченко¹⁾, В.А.Ткаченко^{1,2)}, Д.Г.Бакиев²⁾. Ступени коэффициента прохождения через одномерный барьер в высокочастотном поле. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- П_38** Н.Э.Алимов, К.А.Ботиров, С.М.Отажонов. Фотопроводимость в ультракристаллических гетероструктурах CdTe-SiO₂-Si. Ферганский государственный университет, г. Фергана, Узбекистан.
- П_39** В.М.Ефимов, Е.Р.Закиров, Д.Г.Есаев. Влияние излучения видимого диапазона на проводимость тонких пленок одностенных углеродных нанотрубок. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.*
- П_40** Б.Г.Вайнер^{1,2)}, А.Е.Настовьяк¹⁾. Матричная тепловизионная система, интегрированная в многоканальный автоматизиро-

ванный биомедицинский комплекс. ¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

- П_42** А.Р.Новоселов¹⁾, П.А.Алдохин¹⁾, А.Е.Маточкин²⁾, П.П.Добровольский¹⁾, К.П.Шатунов¹⁾. Эффективные методы контроля формы поверхности компонент флип-чип фотоприёмников. ¹Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск. ²Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

Стендовая сессия-2

- Ч_1** А.И.Козлов¹⁾, А.Р.Новоселов²⁾, М.А.Демьяненко¹⁾, В.Н.Овсяк¹⁾. О мозаичных инфракрасных фотоприемниках сверхвысокой размерности на основе многослойных структур с квантовыми ямами. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск.
- Ч_2** Г.И.Громилин¹⁾, В.П.Косых^{1,2)}, С.А.Попов¹⁾, Б.Н.Дражников³⁾, К.В.Козлов³⁾, В.А.Стрельцов³⁾. Особенности межкадровой обработки последовательности изображений, формируемых сканирующим устройством на основе многорядного ФПУ. ¹Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³АО «НПО «Орион», Москва.
- Ч_3** М.В.Агринский¹⁾, К.Б.Горбачев²⁾, В.В.Олейников³⁾, В.В.Старцев¹⁾. Проектирование и изготовление гиперспектральной камеры для беспилотных летательных аппаратов. ¹АО «Оптико-механическое конструкторское

бюро «АСТРОН», Московская область, г.Лыткарино. ²ОКТБ «Омега», г.Великий Новгород. ³Технический центр «Инженер», Москва.

- Ч_4** А.О.Лебедев. Алгоритм стабилизации видеоизображения при наличии в поле зрения быстро двигающихся объектов. *Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микро-электроники», Новосибирск.*
- Ч_5** В.В.Клечковская¹⁾, А.С.Орехов¹⁾, Т.С.Камилов²⁾, А.С.Рысбаев²⁾, К.К.Курбаналиев²⁾. Влияние эффекта Пельтье на границе раздела ВСМ – Si(Mn), содержащей пористость, на процесс инжекции носителей заряда. ¹*Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН.* ²*Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан.*
- Ч_6** В.Н.Кручинин¹⁾, С.В.Рыхлицкий¹⁾, М.В.Кручинина²⁾, Г.В.Шувалов²⁾, И.В.Минин²⁾, О.В.Минин²⁾. Увеличение длины распространения поверхностных плазмон-поляритонов методами мезоразмерной фотоники. ¹*Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.* ²*Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени институт метрологии, Новосибирск.*
- Ч_7** Н.В.Латухина, Д.А. Лизункова, И.А.Шишкин, В.В.Танеев, В.Д.Паранин. Спектральные характеристики фоточувствительных структур на основе пористого кремния и карбида кремния. *Самарский национальный исследовательский университет им. академика. С.П. Королева, Самара.*
- Ч_8** Д.Мелебаев, И.Н.Туджанова, Т.Д.Пащыкова. Фотоприемник ультрафиолетового излучения на основе Au-Ga₂O₃(Fe)-n-GaAs_{0,6}P_{0,4} наноструктур. *Туркменский госуниверситет им. Махттымкулы, Ашхабад.*

- Ч_9** С.А.Рожков^{1,2)}, В.В.Бакин¹⁾, С.Н.Косолобов¹⁾, Г.Э.Шайблер^{1,2)}, А.С.Терехов¹⁾. Влияние приповерхностного изгиба зон на фотоэмиссионные характеристики р-GaN(Cs,O) фотокатодов. ¹*Институт физики полупроводников им.А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.* ²*Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*
- Ч_10** В.А.Стучинский, А.В.Вишняков, Г.Ю.Сидоров. Влияние ступенчатого профиля состава на формирование инверсии в пленках материала кадмий-ртуть-теллур. *Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.*
- Ч_11** В.А.Стучинский, А.В.Вишняков. Об определении длины диффузии неосновных носителей заряда в материале абсорбера фотодиодных матричных фотоприемников методом сканирования пятна засветки при малых уровнях диодных фототоков. *Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.*
- Ч_12** В.А.Стучинский, А.В.Вишняков, Г.Ю.Сидоров. О различии значений пороговых характеристик многоэлементных фотодиодных ФПУ, определенных в экспериментах с однородной модулированной засветкой фотоприемника и в экспериментах с малым (“пиксельным”) пятном засветки. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.*
- Ч_13** А.И.Козлов¹⁾, А.Р.Новоселов²⁾. Технологические подходы к созданию мозаичных фотоприемников сверхвысокой размерности с предельной эффективностью преобразования изображений. ¹*Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.* ²*Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск.*

Ч_14 А.А.Рыбак^{1,2)}, Н.А.Николаев¹⁾, С.А.Кузнецов^{2,3)}. Повышение технических характеристик импульсных терагерцевых спектрометров с помощью микроструктурных квазиоптических фильтров нижних частот. ¹Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск. ³Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск.

Ч_15 А.С.Москаленко, С.Г.Ясев, А.В.Самвелов, К.С.Павлов. Извлечение ванадия из техногенных руд сернокислотного производства диоксида титана. АО «Оптико-механическое конструкторское бюро «АСТРОН», Московская область, г.Лыткарино.

Ч_16 В.В.Бакин¹⁾, С.А.Рожков^{1,2)}, Г.Э.Шайблер^{1,2)}, С.Н.Косолобов¹⁾, Н.С.Рудая¹⁾, А.С.Кожухов^{1,2)}, А.С.Терехов¹⁾. Формирование атомарно-гладкой эмитирующей поверхности полупрозрачного р-GaAs(Cs,O) – фотокатода. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

Ч_17 А.В.Войцеховский^{1,2)}, С.Н.Несмелов¹⁾, С.М.Дзядух¹⁾, Д.И.Горн¹⁾, В.С.Варавин³⁾, С.А.Дворецкий^{1,3)}, Н.Н.Михайлов³⁾, М.В.Якушев³⁾, Г.Ю.Сидоров³⁾. Электрофизические характеристики *nВп*-структур на основе HgCdTe, выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии. ¹Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск. ²Сибирский физико-технический институт ТГУ, Томск. ³Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.

Ч_18 А.В.Войцеховский^{1,2)}, С.Н.Несмелов¹⁾, С.М.Дзядух¹⁾, В.С.Варавин³⁾, С.А.Дворецкий^{1,3)}, Н.Н.Михайлов³⁾, М.В.Якушев³⁾, Г.Ю.Сидоров³⁾. Диагностика МДП-структур на основе МЛЭ HgCdTe при высокой плотности медленных поверхностных

состояний. ¹Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск. ²Сибирский физико-технический институт ТГУ, Томск. ³Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.

Ч_19 Д.В.Горшков, Г.Ю.Сидоров, Д.В.Марин, И.В.Сабина. Исследование границы раздела ГЭС КРТ МЛЭ и Al₂O₃, нанесенного методом АСО при различных параметрах роста. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.

Ч_20 Л.В.Данилов, Р.В.Левин, И.В.Федоров, Н.В.Павлов, В.Н.Неведомский, Б.В.Пушный, М.П.Михайлова, И.А.Андреев, Г.Г.Зегря. Фотоприемные устройства на основе наноразмерных гетероструктур InAs/GaSb. Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург.

Ч_21 Д.Г.Есаев. Оптимизация параметров фотоприемников дальнего ИК диапазона на основе гетероструктур GaAs/AlGaAs с внутренней фотоэмиссией. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.

Ч_22 А.Е.Маричев, В.С.Эполетов, Р.В.Левин, М.З.Шварц, Б.В.Пушный. Фотоприемники лазерного излучения с $\lambda=1.06$ мкм. Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург.

Ч_23 Г.Ю.Сидоров, И.В.Сабина, Д.В.Марин, М.В.Якушев, Ю.Г.Сидоров, А.О.Сусяков, С.А.Дворецкий, В.В.Васильев, А.В.Зверев, Ю.С.Макаров, А.В.Предеин, А.В.Вишняков, Д.В.Горшков, В.Г.Ремесник. Линейчатые фотоприемники формата 288×4 на основе ГЭС КРТ МЛЭ на подложках из кремния для диапазона 8-12.5 мкм. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.

Ч_24 Р.И.Баталов¹⁾, Р.М.Баязитов¹⁾, И.А.Файзрахманов¹⁾, В.А.Шустов¹⁾, А.В.Новиков²⁾, П.А.Бушуйкин²⁾, Н.А.Байдакова²⁾, М.Н.Дроздов²⁾. Формирование светоизлучающих и

фотодетектирующих в ИК-области тонкослойных структур Ge:Sb/Ge методами ионной имплантации, вакуумного осаждения и импульсного отжига. ¹Казанский физико-технический институт, Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН», Казань. ²Институт физики микроструктур, Федеральный исследовательский центр «Институт прикладной физики РАН», Нижний Новгород.

- Ч_25** А.В.Войцеховский^{1,2)}, С.Н.Несмелов¹⁾, С.М.Дзядух¹⁾, А.П.Коханенко¹⁾. Электрофизические и оптические свойства органических светодиодных структур с эмиссионным слоем ЯК-203. ¹Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск. ²Сибирский физико-технический институт ТГУ, Томск.
- Ч_26** А.В.Войцеховский^{1,2)}, С.Н.Несмелов¹⁾, С.М.Дзядух¹⁾. Адмиттанс гибридных органо-неорганических структур на основе пентацена в широком диапазоне температур. ¹Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск. ²Сибирский физико-технический институт ТГУ, Томск.
- Ч_27** М.П.Гамбарян¹⁾, С.Г.Черкова¹⁾, В.А.Володин^{1,2)}. ИК-фотолюминесценция плёнок $Ge_xSi_yO_z$: вклад дефектов и нанокластеров германия. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Рожанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- Ч_28** Н.В.Латухина¹⁾, И.М.Жильцов¹⁾, М.Б.Степихова²⁾. Оптические и электрические свойства диодных структур на базе пористого кремния с эрбием. ¹Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Самара. ²Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород.
- Ч_29** К.Д.Мынбаев^{1,2)}, А.А.Семакова^{1,2)}, С.Н.Липницкая¹⁾, Н.Л.Баженков²⁾, А.В.Черняев^{2,3)}, С.С.Кижяев³⁾, Н.Д.Стоянов³⁾. Спонтанное и стимулированное излучение в светодиодных

гетероструктурах с активной областью из InAs. ¹Университет ИТМО, Санкт-Петербург. ²Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург. ³ООО «Микросенсор Технолоджи», Санкт-Петербург.

- Ч_30** Н.А.Солдатов¹⁾, Д.В.Дмитриев¹⁾, К.С.Журавлев^{1,2)}. Разработка мощных ИК диодов с РБО на 850 и 920 нм методом МЛЭ. ¹Институт физики полупроводников им. А. В. Рожанова, Новосибирск. ²Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- Ч_31** К.В. Феклистов¹⁾, А.В. Гуляев¹⁾, А.Г. Лемзяков²⁾. Фотолюминесценция эрбия в In_2O_3 . ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Рожанова СО РАН, Новосибирск. ²Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск.
- Ч_33** А.И.Козлов¹⁾, А.Р.Новоселов²⁾, В.Н.Овсяк¹⁾. Дизайнерские принципы устранения потерь изображений в мозаичных фотоприемниках сверхвысокой размерности. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Рожанова СО РАН, Новосибирск. ²Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск.
- Ч_34** А.В.Вишняков¹⁾, В.В.Васильев¹⁾, И.В.Сабина¹⁾, Г.Ю.Сидоров¹⁾, В.А.Стучинский¹⁾. Моделирование пространственного разрешения ИК КРТ ФПУ методом Монте Карло. ¹Институт физики полупроводников им. А.В.Рожанова СО РАН, Новосибирск.
- Ч_35** А.Г.Паулиш^{1,2)}, П.С.Загубисало¹⁾. Коэффициенты тензочувствительности датчиков механических напряжений на разных физических принципах. ¹Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск. ²Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.

Ч_36 *И.И.Кремис*, *Р.А.Гладков*. Перспективы формирования качественного изображения в тепловизорах на базе отечественных фотоприемников КРТ. *Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск.*

Ч_37 *И.И.Кремис*, *Р.А.Гладков*. Методика настройки микросканера на базе плоскопараллельной пластинки. *Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск.*

Ч_38 *Р.А.Гладков*, *И.И.Кремис*. Методика определения клиновидности плоскопараллельной пластинки (в дополнение к методике настройки микросканера на базе плоскопараллельной пластинки). *Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск.*

Ч_39 *И.И.Ижнин*^{1,2)}, *А.В.Войцеховский*²⁾, *А.Г.Коротаев*²⁾, *К.Д.Мынбаев*^{3,4)}, *О.Ю.Бончик*⁵⁾, *Г.В.Савицкий*⁵⁾, *В.С.Варавин*⁶⁾, *С.А.Дворецкий*^{2,6)}, *Н.Н.Михайлов*⁶⁾, *В.Г.Ремесник*⁶⁾, *М.В.Якушев*⁶⁾, *Y.Morgiel*⁷⁾, *Z.Świątek*⁷⁾. Термические отжиги имплантированных мышьяком МЛЭ пленок CdHgTe. ¹Научно-производственное предприятие «Электрон-Карат», Львов. ²Национальный исследовательский Томский госуниверситет, Томск. ³Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург. ⁴Университет ИТМО, Санкт-Петербург. ⁵ИППММ им. Я.С. Пидстригача НАН Украины, Львов, Украина. ⁶Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. ⁷Institute of Metallurgy and Material Science PAN, Krakow, Poland.

Ч_40 *П.С.Загубисало*, *А.Р.Новоселов*. Моделирование напряжений в In-столбах связи фотоприёмников при охлаждении их до температур жидкого азота. *Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск.*

Ч_41 *П.С.Загубисало*¹⁾, *А.Г.Паулиш*^{1,2)}. Исследование влияния температуры на характеристики пьезооптических датчиков механических напряжений. ¹Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск. ²Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.